

エピタキシャル形シリコンダブルダイオード (直列接続)
高速スイッチング用

Silicon Epitaxial Double Diode
(Series Connected)
High Speed Switching

特長 / FEATURES

- 超小形で混成集積回路に最適な外形です。
- スwitching速度が早い: $t_{rr} < 9$ ns
- 直列接続なのでバイアス回路等に広く応用できます。

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25$ °C)

項目	略号	定格	単位
せん頭逆電圧	V_{RM}	70	V
直流逆電圧	V_R	70	V
せん頭順電流	I_{RM}	200	mA
平均整流電流	I_O	100	mA
直流順電流	I_F	100	mA
ジャンクション温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C

* ダイオード1個当たり / Per Diode

熱的特性 / THERMAL CHARACTERISTICS

項目	略号	定格
熱抵抗	$R_{th(j-a)}$	1.1 °C/mW (2ダイオード同時通電)
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	670 °C/W (1ダイオード通電)

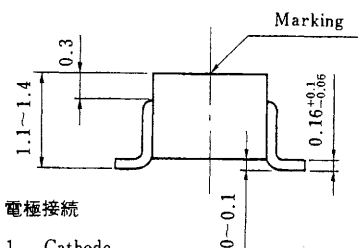
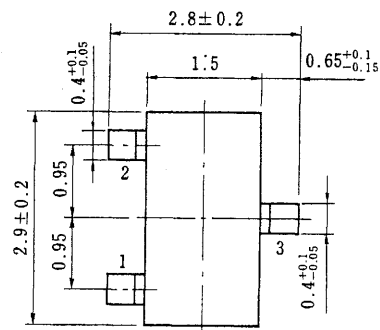
電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25$ °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
順電圧	V_F	$I_F = 1.0$ mA		600	715	mV
順電圧	V_F	$I_F = 10$ mA		750	855	mV
順電圧	V_F	$I_F = 50$ mA		850	1100	mV
順電圧	V_F	$I_F = 100$ mA		900	1300	mV
逆電流	I_R	$V_R = 70$ V			1.0	μA
端子間容量	C_t	$V_R = 0, f = 1.0$ MHz			4.0	pF
順回復電圧	V_{fr}	測定回路参照 ($I_F = 10$ mA)			1.75	V
逆回復時間	t_{rr}	測定回路参照 ($I_F = 10$ mA, $V_R = 1$ V, $R_L = 100$ Ω)			9.0	ns

* ダイオード1個当たり / Per Diode

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)

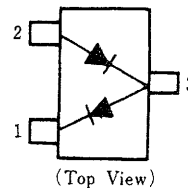


電極接続

1. Cathode
2. Anode
3. Anode + Cathode

表示 / Marking

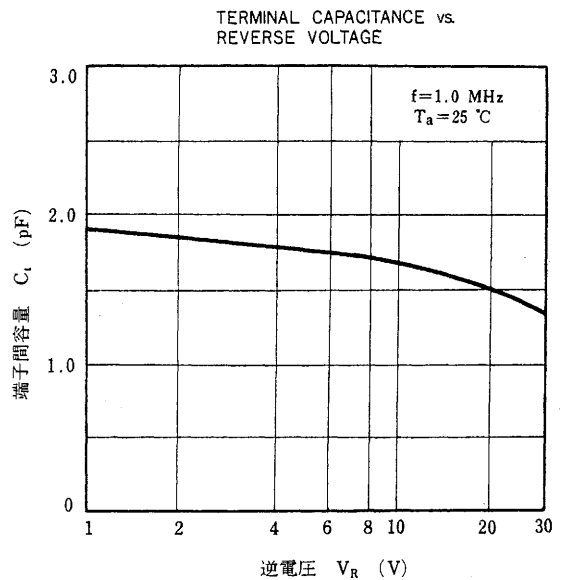
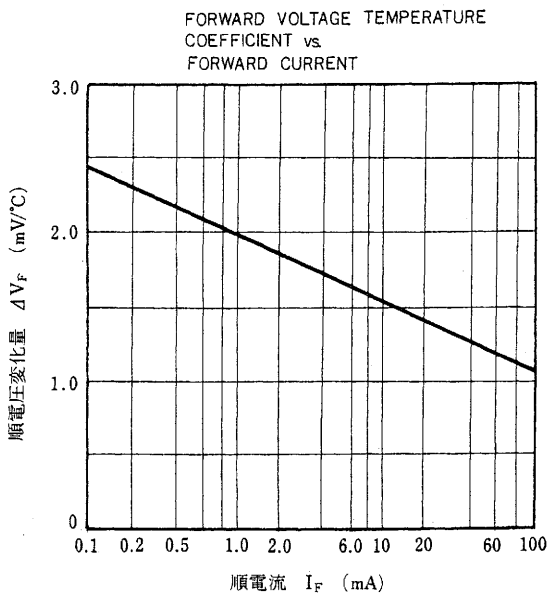
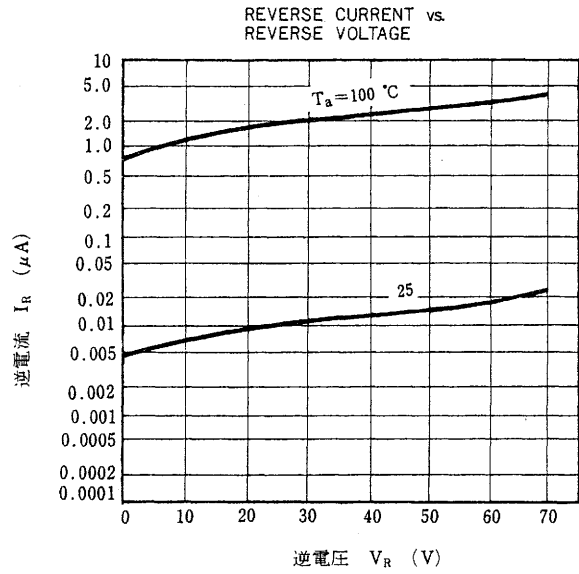
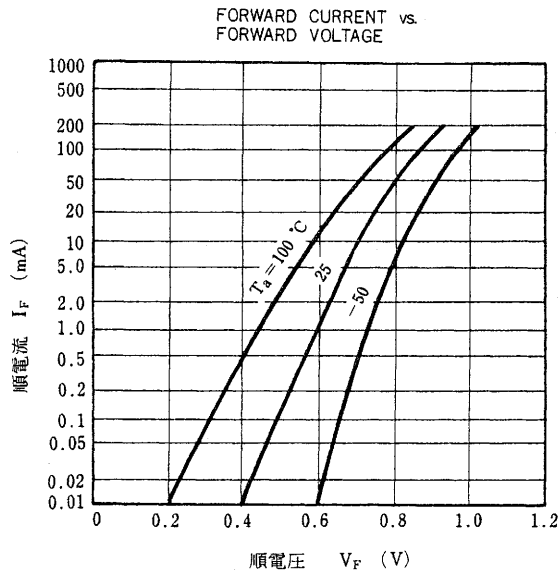
A7



(Top View)

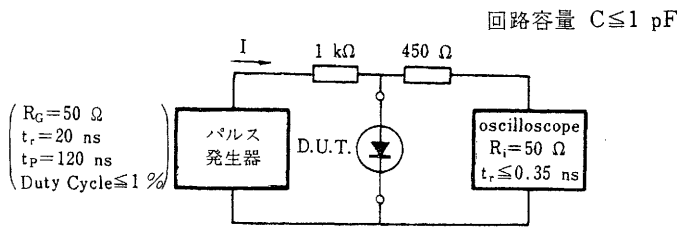
本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものとご確認の上ご使用ください。

特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

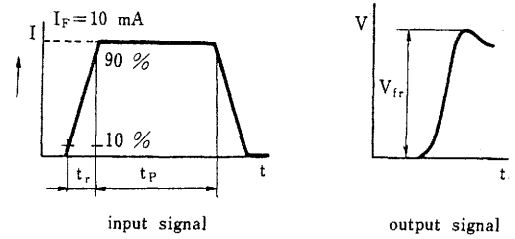


スイッチング特性測定回路 / SWITCHING CHARACTERISTICS TEST CIRCUIT

順回復電圧 / Forward recovery voltage

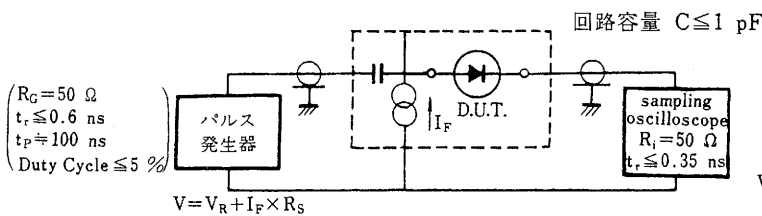


測定回路 / Test circuit



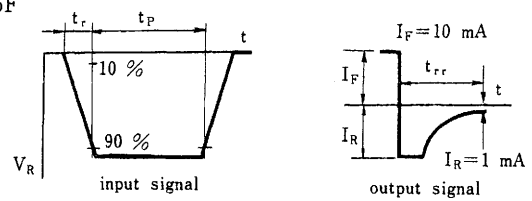
波形 / Wave forms

逆回復時間 / Reverse recovery time



測定回路 / Test circuit

測定条件 / $I_F = 10 \text{ mA}$, $V_R = 1.0 \text{ V}$



波形 / Wave forms